	SPECIFICATION TRANSISTORS, DIODES	
NO. 17 — 2T—1323	2 S C 1 4 7 5	
PAGE: 2/20/'73	暫　定	

DATE: / /

1. 構　造　　NPN・APM形・エピタキシヤル・シリコン・トランジスタ
2. 用　途　　低周波～高周波電力増巾，スイッチング
3. 外　形　　付図参照
4. 絶対最大定格（Ta＝25℃）

コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	100V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6V
コレクタ電流	I_C	1A
ベース電流	I_B	0.5A
コレクタ損失	P_C	750mW
ジヤンクション温度	T_j	150℃
保存温度	T_{stg}	−50℃～+150℃

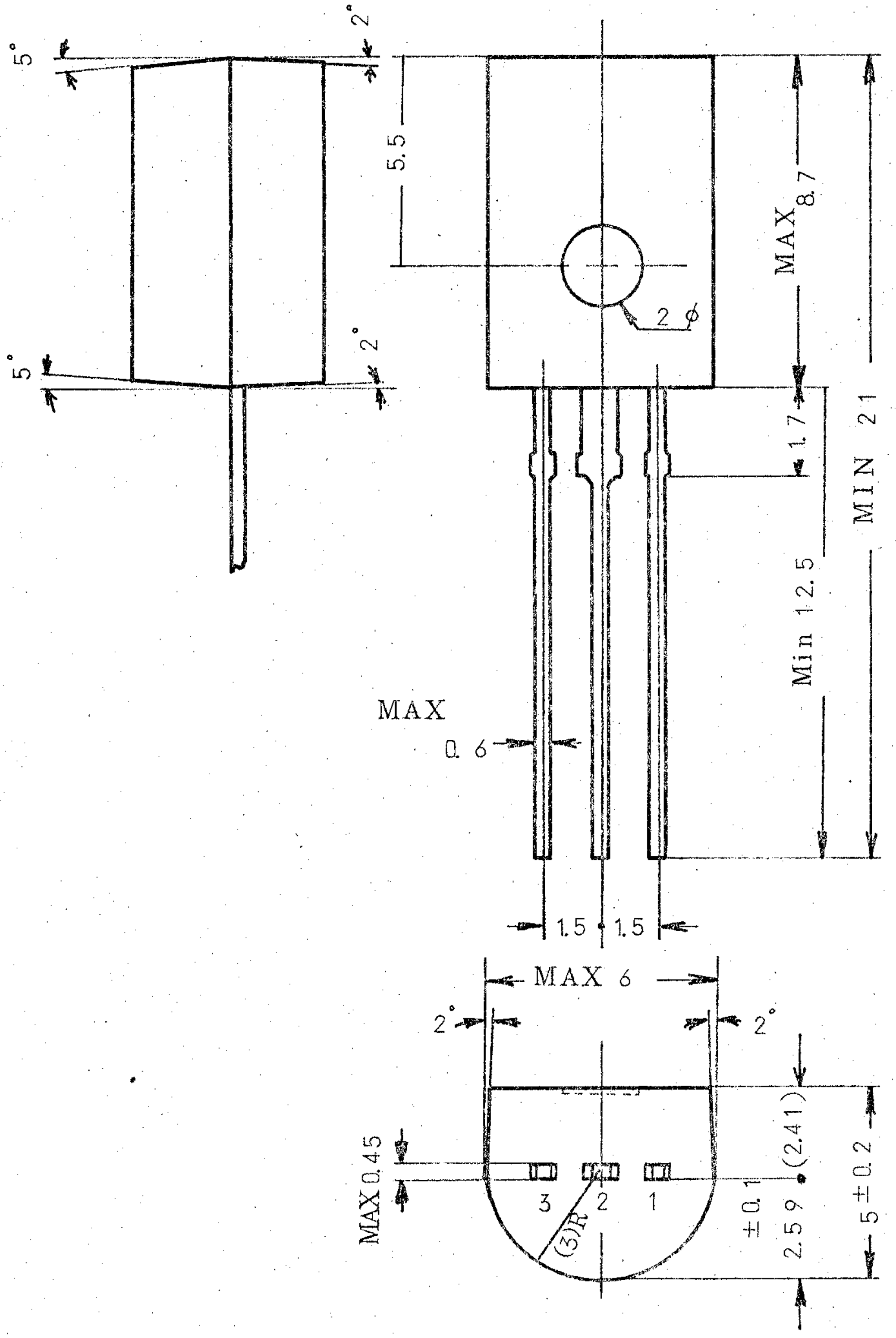
GAIN GROUPS - 2, 3, 4 @ our option
10K @ .20
30 Days from D.O.A.

5. 電気的特性（Ta＝25℃）

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=25V, I_E=0			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	V_{EB}=6V, I_C=0			0.2	μA
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=6V, I_C=5mA			0.70	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	I_C=2mA	50			V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=1A, I_B=50mA			0.3	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=1A, I_B=50mA			1.0	V
直流電流増巾率	h_{FE1}	V_{CE}=2V, I_C=100mA	98		649	
直流電流増巾率	h_{FE2}	V_{CE}=1V, I_C=1A	70			
小信号電流増巾率	$\|h_{fe}\|$	V_{CB}=2V, I_E=10mA, f=10MHz		18		dB
コレクタ出力容量	C_C	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz		16	40	pF
熱抵抗	θ_{j-a}				126	℃/W

6. 規格細分

	h_{FE1} (V_{CE}=2V, I_C=100mA)	
	最小値	最大値
1	98	156
2	140	222
3	199	316
4	285	451
5	409	649



1 ベース

2 コレクタ

3 エミッタ

〔mm〕